

## Общая информация

Блок ЭСПЗУ с объемом памяти 7 кБайт и блоком питания для генерации высоковольтных сигналов записи и стирания использует два напряжения питания  $v_{dd} = 1.5-2.2$  В и  $v_{ps} = 2.6-5.5$  В. Матрица памяти содержит 112 строк по 16 слов. Разрядность слова  $32 + 7 = 39$  бит для возможности реализации в контроллере блока памяти самокорректирующегося кода Хэмминга. Запись любого числа слов от 1 до 16 в пределах одной строки. В процессе записи сначала производится стирание всех ячеек записываемых слов, а затем их программирование в соответствии с записываемыми данными. Чтение осуществляется словами по 39 бит.

## Функциональные особенности

- Напряжение питания  $v_{dd}$  1.5-2.2 В
- Напряжение питания  $v_{ps}$  2.6-5.5 В
- Технология CMOSF8 (4 слоя металлизации, питания 1.8 В и 5 В)
- Ток потребления:
  - режим чтения < 1.4 мА
  - режим записи < 2.5 мА
- Время записи 6-10 мс
- Время чтения 0.5-2 мкс
- Число циклов перезаписи > 100 тыс.
- Время хранения данных > 10 лет
- Температурный диапазон  $-40^{\circ}\text{C} - 85^{\circ}\text{C}$
- Размеры блока памяти 1.034 мм x 0.656 мм,
- Размеры блока питания 0.706 мм x 0.115 мм

Информация о СФ-блоке	
Тип СФ-блока	Hard IP
Статус	Проверен в кремнии
Поддерживаемые техпроцессы	CMOSF8
Поддерживаемые интерфейсы	Параллельный
Размеры	
X;Y	Блок памяти 1.034 мм; 0.656 мм  Блок питания 0.706 мм; 0.115 мм
Файлы, сопровождающие СФ-блок	
Документация	Спецификация
Файлы проекта	gds, lef, cdl, drc.summary, lvs.report
Пример проекта	Нет
Тестовый модуль	Нет
Файл ограничений	Нет
Модель	lib, поведенческое описание Verilog
Стоимость СФ-блока и технической поддержки	
По запросу	